

Market News

StrongIRFET™-MOSFETs im D²PAK 7pin+ Gehäuse für batteriebetriebene Anwendungen

München, 12. Mai 2020 – Die Infineon Technologies AG erweitert mit drei neuen Leistungsbausteinen im D²PAK 7pin+ Gehäuse ihre [StrongIRFET™ MOSFET-Produktfamilie mit 40 V bis 60 V](#). Die neuen Komponenten bieten einen sehr geringen Durchlasswiderstand ($R_{DS(on)}$) und eine hohe Stromtragfähigkeit. Dies steigert die Robustheit und Zuverlässigkeit von Anwendungen mit hoher Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad. Die drei neuen MOSFETs sind für batteriebetriebene Anwendungen wie Akku-Werkzeuge, Batterie-Management-Systeme und Niedervolt-Antriebe geeignet.

Das neue D²PAK 7pin+ Gehäuse ergänzt das bereits große Angebot an StrongIRFET™-Gehäusen. Entwickler erhalten so noch mehr Möglichkeiten, den idealen Leistungsbaustein für unterschiedlichste Designanforderungen auszuwählen. Darüber hinaus eröffnet die pin-kompatible Anschlussbelegung des neuen Gehäuses eine beispiellose Design-Flexibilität. Im Vergleich zur Vorgängergeneration in einem Standard-D²PAK 7pin Gehäuse bietet die neue Familie einen um 13 Prozent geringeren $R_{DS(on)}$ und eine um bis zu 50 Prozent größere Stromtragfähigkeit. So erreicht der 40-V-Baustein [IRL40SC240](#) einen Durchlasswiderstand $R_{DS(on)}$ von nur 0,65 mΩ und eine Stromtragfähigkeit von 360 A.

Das neue Gehäuse wurde dafür optimiert, einen Chip mit einer um 20 Prozent größeren Fläche aufzunehmen, während die Grundfläche und die Pin-Belegung wie bei einem standardmäßigen D²PAK 7pin beibehalten werden. Damit können MOSFETs in dem neuen Gehäuse unkompliziert Komponenten in bisherigen D²PAK 7pin- und H²PAK-Gehäusen ersetzen. Zudem bietet die Produktfamilie Versionen mit Logik-, als auch normal-Level Gate-threshold Spannungen ($V_{GS(th)}$). Dies ermöglicht zusätzliche Flexibilität bei der Entwicklung der Treiberschaltungen.

Verfügbarkeit

Der StrongIRFET im D²PAK 7pin+ Gehäuse ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/strongirfet.